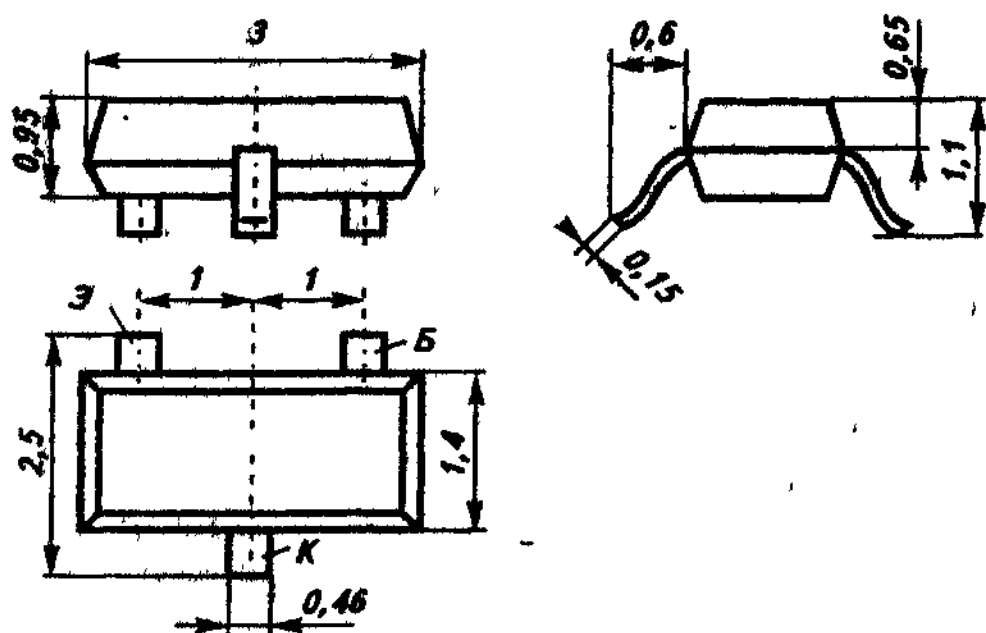


□ 2Т214А9, 2Т214Б9, 2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214Д9, 2Т214Е9



2Т214 (А9-Е9)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах герметизированной аппаратуры. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,1 г.

Электрические параметры

Коэффициент шума на $f = 1$ кГц при $U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 40$ мА, $R_r = 10$ кОм для 2Т214Д9	1,8*...3,5*...5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:	
при $T = +25^\circ\text{C}$, $U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 10$ мА:	
2Т214А9, не менее	20
2Т214Б9	30...90
2Т214В9, 2Т214Г9	40...120
при $T = +25^\circ\text{C}$, $U_{кб} = 1$ В, $I_{э} = 40$ мкА, не менее:	
2Т214Д9	80
2Т214Е9	40
при $T = -60^\circ\text{C}$:	
$U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 10$ мА:	
2Т214А9, не менее	7
2Т214Б9	10...90
2Т214В9, 2Т214Г9	15...120
$U_{кб} = 1$ В, $I_{э} = 40$ мкА, не менее:	
2Т214Д9	25
2Т214Е9	15
при $T = +85^\circ\text{C}$:	
$U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 10$ мА:	
2Т214А9, не менее	20
2Т214Б9	30...150
2Т214В9, 2Т214Г9	40...200
$U_{кб} = 1$ В, $I_{э} = 40$ мкА, не менее:	
2Т214Д9	80
2Т214Е9	40
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 1$ мА	5...20*...30* МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 2$ мА, $f = 5$ МГц, не более	5 нс

типовое значение	1* нс
Граничное напряжение при $I_{э} = 10$ мА, не менее:	
2Т214А9, 2Т214Б9	80 В
2Т214В9	60 В
2Т214Г9	40 В
2Т214Д9	30 В
2Т214Е9	20 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 1$ мА, не более	0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 1$ мА, не более	1,2 В
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при $U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 2$ мА, $f = 800$ Гц	1,2...2,5...10 кОм
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	10 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = U_{кз}$, макс, $R_{бэ} = 10$ кОм, не более:	
$T = +25^\circ\text{C}$ и -60°C	1 мкА
$T = +85^\circ\text{C}$	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = U_{эб}$, макс не более	10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 10$ кОм:	
2Т214А9	100 В
2Т214Б9	90 В
2Т214В9	80 В
2Т214Г9	60 В
2Т214Д9, 2Т214Е9	30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база:	
2Т214А9	30 В
2Т214Б9, 2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214Д9	7 В
2Т214Е9	20 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10$ мс, $Q = 100$	100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60...+25^\circ\text{C}$	200 мВт
Температура <i>p-n</i> перехода	+125°C
Температура окружающей среды	-60...+85°C